



Описание и технические параметры

Транзистор 2Т637А-2 кремниевый эпитаксиально-планарный структуры n-p-n генераторный, применяется в генераторах и усилителях мощности в схеме с общей базой в герметизированной аппаратуре.

Бескорпусный с защитным покрытием с гибкими выводами на кристаллодержателе. Тип прибора указывается в этикетке. Масса не более 0,15 г.

Технические характеристики транзистора кремниевого эпитаксиально-планарного генераторного 2Т637А-2:

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт - 1,5

Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером, не менее, МГц - 1300

Максимальное напряжение коллектор-база, В - 30

Максимальное напряжение эмиттер-база, В - 2,5

Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА - 200

Максимально допустимый импульсный ток коллектора, мА - 300

Обратный ток коллектора, не более, мА - 0,1

Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером - от 30 до 90

Емкость коллекторного перехода, не более, пФ - 4,5

Выходная мощность транзистора, не менее, Вт - 0,4

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, не более, пс - 3